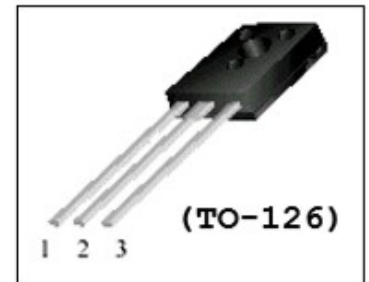


**КТ646А,Б,В****PNP КРЕМНИЕВЫЕ ЭПИТАКСИАЛЬНО - ПЛАНАРНЫЕ  
ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЕ ТРАНЗИСТОРЫ**

ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ РАБОТЫ В ПРИЁМОУСИЛИТЕЛЬНЫХ СХЕМАХ, ОПЕРАТИВНЫХ И ПОСТОЯННЫХ ЗАПОМИНАЮЩИХ УСТРОЙСТВАХ И ДРУГОЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКОЙ АППАРАТУРЕ.

\* Зарубежный аналог: **КТ646А-2SC495, КТ646Б-2SC496.**

\* Изготавливается в корпусе **КТ-27 (ТО-126).**



**1 – эмиттер 2 – коллектор 3 – база**

**ПРЕДЕЛЬНО- ДОПУСТИМЫЕ РЕЖИМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Параметры	Обозначение	Единица измер.	Значение		
			А	Б	В
Напряжение коллектор-эмиттер	Uкэ max	В	60	40	40
Напряжение эмиттер-база	Uэб max	В	4	4	4
Напряжение коллектор-база	Uкб max	В	60	40	40
Постоянный ток коллектора	Iк max	мА	1000	100 0	100 0
Температура перехода	Tпер	°С	150	150	150

**ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ( Токр.ср.=+25°С )**

Параметры	Обозначение	Ед. измер	Режимы измерения	Min	Max
Обратный ток коллектора	Iкбо	мкА	Uкб=60 В	-	10
			Uкб=40 В	-	10
			Uкб=35 В	-	0,05
Статический коэффициент передачи тока	h <sub>21э</sub>		Uкб=5 В, Iэ=200мА	40	200
			Uкб=10 В, Iэ=500мА	150	-
				150	340
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер	Uкэ (нас)	В	Iк=500мА, Iб=50 мА	-	0,85
			Iк=200мА, Iб=20 мА	-	0,25
			Iк=500мА, Iб=50 мА	-	0,25
Напряжение насыщения база - эмиттер	Uэб(нас)	В	Iк= 500мА, Iб=50мА	-	1,2
Емкость коллекторного перехода*	Ск*	пФ	Uкб= 10 В, Iэ= 0, f= 10 <sup>7</sup> Гц	-	10
Емкость эмиттерного перехода*	Сэ*	пФ	Uэб= 0 В, f= 10 <sup>7</sup> Гц	-	80
Обратный ток эмиттера	Iэбо	мкА	Uэбо= 4В	-	10